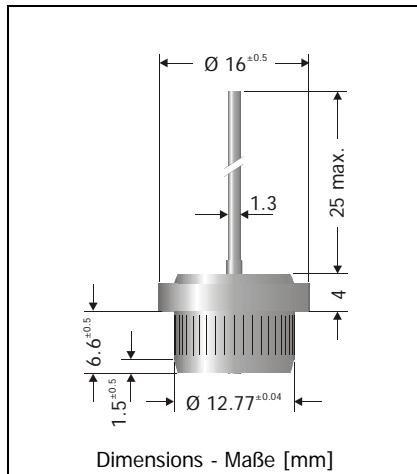


KYW35A05 ... KYW35A6, KYW35K05 ... KYW35K6

Silicon-Press-Fit-Diodes – High Temperature Diodes
Silizium-Einpress-Dioden – Hochtemperatur-Dioden

Version 2006-04-22

Nominal Current
Nennstrom

35 A

Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung

50 ... 600 V

Metal press-fit case with glass seal
Metall-Einpressgehäuse mit Glas-DurchführungWeight approx.
Gewicht ca.

10 g

Compound has classification UL94V-0
Vergussmasse nach UL94V-0 klassifiziertStandard packaging: bulk
Standard Lieferform: lose im Karton**Maximum ratings****Grenzwerte**

Type / Typ Wire to / Draht an	Anode	Cathode	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]
KYW35A05	KYW35K05		50	60
KYW35A1	KYW35K1		100	120
KYW35A2	KYW35K2		200	240
KYW35A3	KYW35K3		300	360
KYW35A4	KYW35K4		400	480
KYW35A6	KYW35K6		600	700

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$T_c = 100^\circ\text{C}$	I_{FAV}	35 A
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15 \text{ Hz}$	I_{FRM}	130 A ¹⁾
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	360/400 A
Rating for fusing, $t < 10 \text{ ms}$ Grenzlastintegral, $t < 10 \text{ ms}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$	i^2t	660 A ² s
Operating junction temperature – Sperrschiichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur	T_J	T_S	-50...+175°C
			-50...+175°C

¹ Max. case temperature $T_c = 150^\circ\text{C}$ – Max. Gehäusetemperatur $T_c = 150^\circ\text{C}$

Characteristics
Kennwerte

Forward Voltage – Durchlass-Spannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 35 \text{ A}$	V_F	< 1.1 V
Leakage Current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	I_R	< 100 μA
Thermal Resistance Junction – Case Wärmewiderstand Sperrsicht – Gehäuse			R_{thC}	< 0.8 K/W

